

シリコンNPN三重拡散メサ形トランジスタ
SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED MESA TRANSISTOR

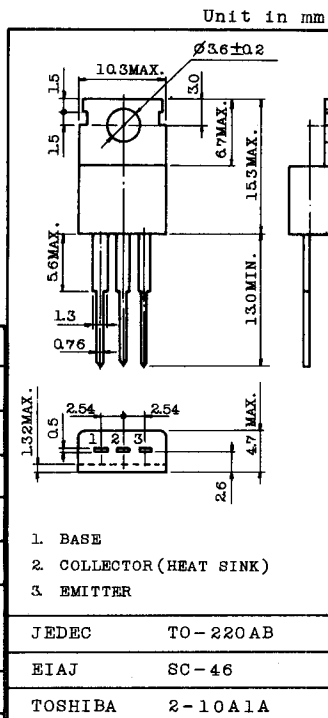
2SC2073

- 電力増幅用
- 垂直偏向出力用
- Power Amplifier Applications.
- Vertical Output Applications.

2SA940とコンプリメンタリになります。
Complementary to 2SA940.

最大 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	150	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	5	V
コレクタ電流	I _C	15	A
エミッタ電流	I _E	-1.5	A
コレクタ損失	P _C	(Ta=25°C)	1.5
		(Tc=25°C)	25
接合温度	T _j	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55~150	°C

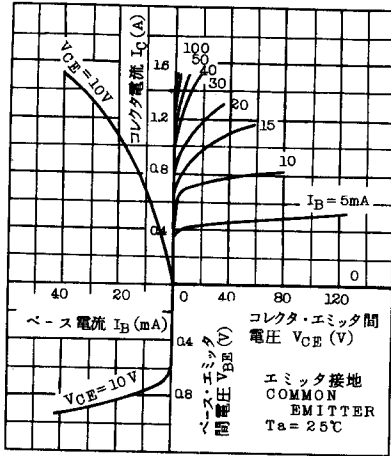


アクセサリはAC75を適用
MOUNTING KIT No. AC75

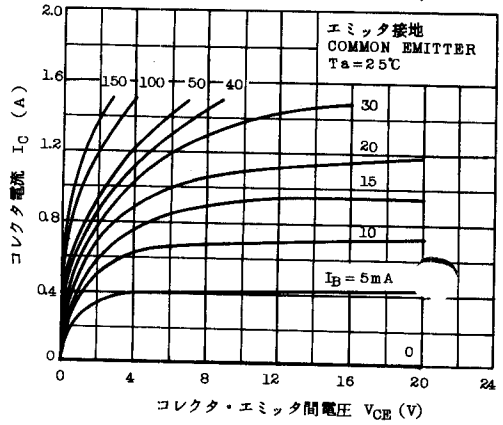
電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =120V, I _E =0	—	—	10	μA
エミッタシャ断電流	I _{EB0}	V _{EB} =5V, I _C =0	—	—	10	μA
直流電流増幅率	h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =500mA	40	75	140	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(eat)}	I _C =500mA, I _B =50mA	—	—	1.5	V
ベース・エミッタ間電圧	V _{BE}	V _{CE} =10V, I _C =500mA	0.65	0.75	0.85	V
トランジション周波数	f _T	V _{CE} =10V, I _C =500mA	—	4	—	MHz
コレクタ出力容量	C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1MHz	—	35	—	pF

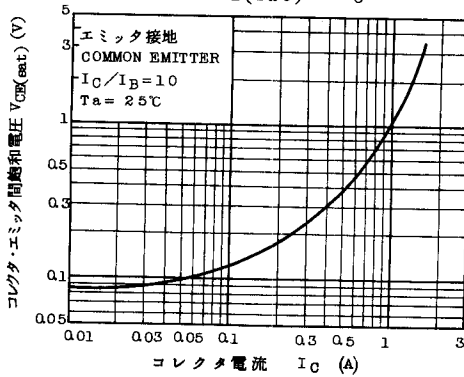
STATIC CHARACTERISTICS



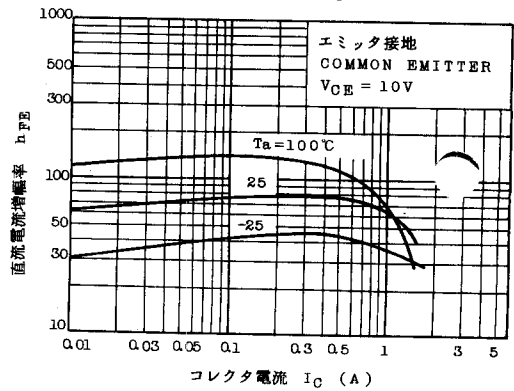
$I_C - V_{CE}$ (LOW VOLTAGE REGION)



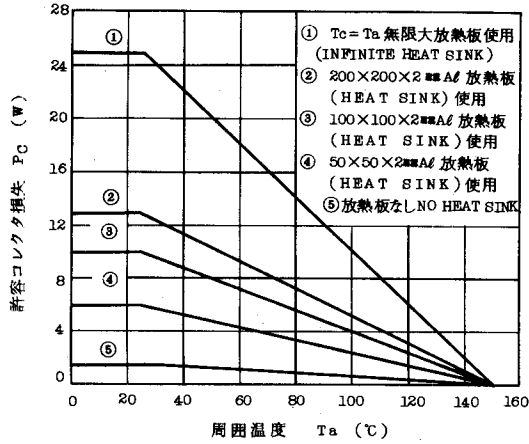
$V_{CE(sat)} - I_C$



$h_{FE} - I_C$



$P_C - T_a$



安全動作領域 ASO

